

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



(10) 国際公開番号

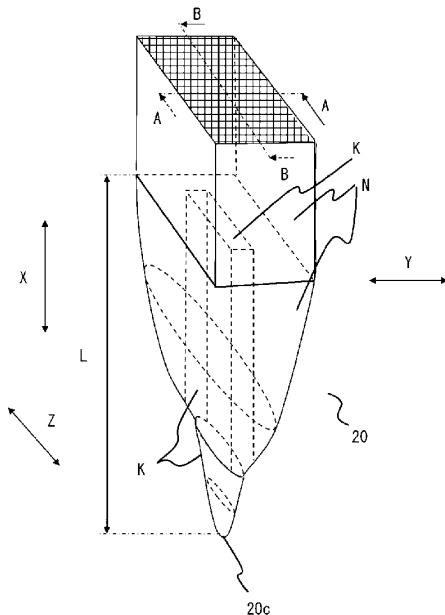
WO 2023/188166 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 1/067 (2006.01) G01R 31/26 (2020.01)
G01R 1/073 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/016176
- (22) 国際出願日: 2022年3月30日(30.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 日本電子材料株式会社 (JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 森 親臣 (MORI Chikaomi); 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号 日本電子材料株式会社内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人ぱるも特許事務所 (PALMO PATENT FIRM, P.C.); 〒6610033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目35番8号 Hyogo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) Title: PROBE, PROBE CARD, AND PROBE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: プローブ、プローブカード、およびプローブの製造方法

[図2]



(57) Abstract: A probe comprises a first metal part (N) and a plate-shaped second metal part (K). The second metal part (K) is embedded in one end of the first metal part (N) in the longitudinal direction (X) thereof in a predetermined range, protrudes from the first metal part (N) in the longitudinal direction (X), and has a contact section (20c) that makes contact with an electrode of a semiconductor device. A cross-section of the contact section (20c) perpendicular to the longitudinal direction (X) is circular, and a cross-section perpendicular to the longitudinal direction (X) of the end section of the second metal part (K) on the opposite side to the contact section (20c) is rectangular.

(57) 要約: 第1金属部(N)と、板状の第2金属部(K)とからなり、第2金属部(K)は、第1金属部(N)の長手方向(X)の一端側に、予め定められた範囲において長手方向(X)に埋め込まれると共に、第1金属部(N)から長手方向(X)に突出し、半導体デバイスの電極に接触させるコンタクト部(20c)を有し、コンタクト部(20c)の長手方向(X)に対して垂直な断面は円形であり、コンタクト部(20c)とは、長手方向(X)に反対側の第2金属部(K)の端部の、長手方向(X)に対して垂直な断面は矩形である。

[続葉有]

MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）